

SANYO

三洋半導体ニュース

No. N7449

31504

新

TND721MH5 — エクセレントパワーデバイス IGBT ドライバー

- 特長**
- ・バッファタイプ。
 - ・モノリシック構造(CMOS プロセス採用)。
 - ・駆動回路の構成簡素化が可能。
 - ・TTL / CMOS コンパチブル($V_{IH}=2.0V$ 以下、at $V_{DD}=2.5 \sim 5.5V$)。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / $T_a=25$ (電圧パラメータは、GND 端子に対する電圧)

			unit
電源電圧	V_{DD}	- 0.3 ~ + 7.5	V
入力電圧	V_{IN}	- 0.3 ~ $V_{DD} + 0.3$	V
出力電圧	V_{OUT}	- 0.3 ~ $V_{DD} + 0.3$	V
許容損失	P_D	セラミック基板(600mm ² × 0.8mm)装着時	0.8 W
接合部温度	T_j	- 55 ~ + 150	
保存周囲温度	T_{stg}	- 55 ~ + 150	

推奨動作条件 Recommended Operating Conditions / $T_a=25$ (電圧パラメータは、GND 端子に対する電圧)

			unit
電源電圧	V_{DD}	2.5 ~ + 5.5	V
入力電圧	V_{IN}	0 ~ V_{DD}	V
出力電圧	V_{OUT}	0 ~ V_{DD}	V
動作周囲温度	T_{opr}	- 40 ~ + 85	

電気的特性 (AC 特性) Electrical Characteristics / $T_a=25$, $V_{IN}=2.5V \sim V_{DD}$, $C_L=5000pF$

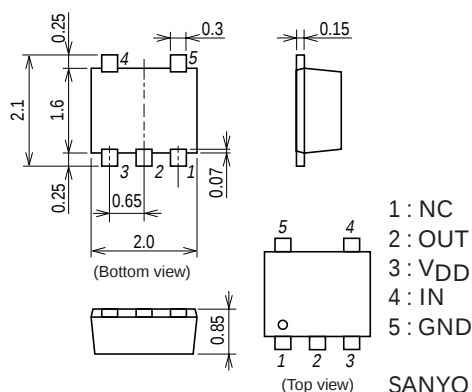
			min	typ	max	unit
ターンオン上昇時間	t_r	$V_{DD}=5V$		500	1000	ns
		$V_{DD}=2.5V$		1200	2000	ns
ターンオフ下降時間	t_f	$V_{DD}=5V$		500	1000	ns
		$V_{DD}=2.5V$		1400	2000	ns

次ページへ続く。

単体品名表示 : XL

外形図 2220

(unit : mm)



■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっていません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

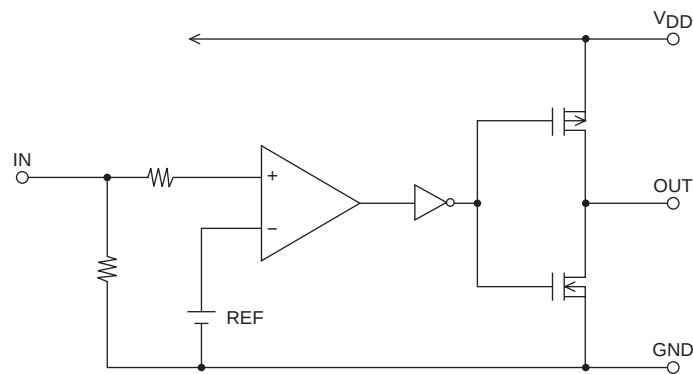
■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

TND721MH5

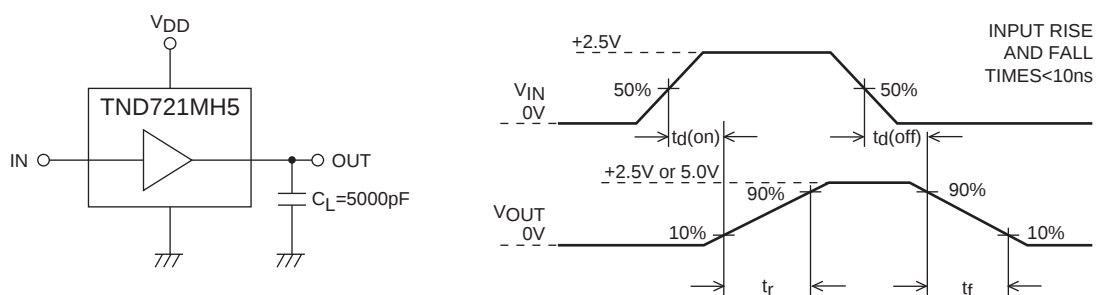
前ページより続く。

			min	typ	max	unit
ターンオン遅延時間	td(on)	VDD=5V		150	500	ns
		VDD=2.5V		300	1000	ns
ターンオフ遅延時間	td(off)	VDD=5V		500	1000	ns
		VDD=2.5V		1200	2000	ns
電気的特性 (DC 特性) Electrical Characteristics / Ta=25℃, VDD=2.5 ~ 5.5V			min	typ	max	unit
入力「H」レベル電圧	VIH		2.0			V
入力「L」レベル電圧	VIL				1.0	V
入力「H」レベルもれ電流	IIN +	VIN=VDD			100	μA
入力「L」レベルもれ電流	IIN -	VIN=0			1	μA
スタンバイ時電源電流	IDD	VIN=0 or VDD			500	μA
出力「H」負荷短絡パルス電流	IO +	VDD=5V, VOUT=0, CL=5000pF		50		mA
		VDD=2.5V, VOUT=0, CL=5000pF		10		mA
出力「L」負荷短絡パルス電流	IO -	VDD=5V, VOUT=VDD, CL=5000pF		50		mA
		VDD=2.5V, VOUT=VDD, CL=5000pF		10		mA

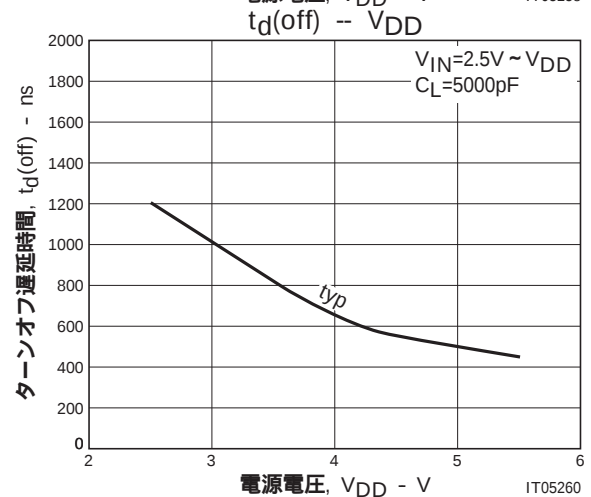
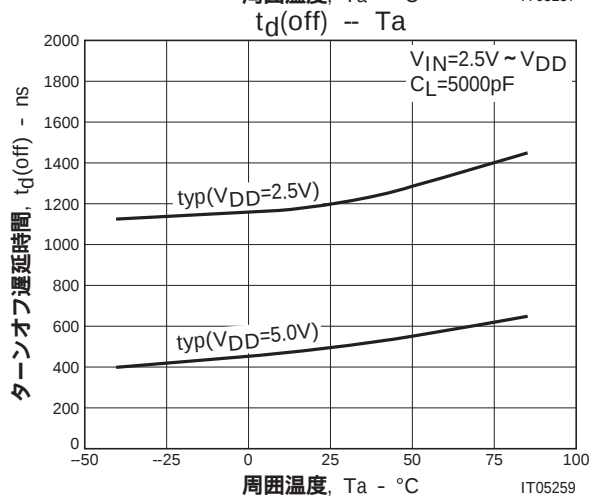
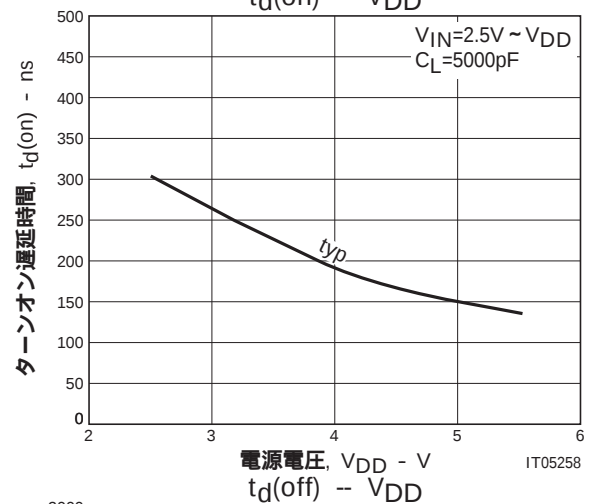
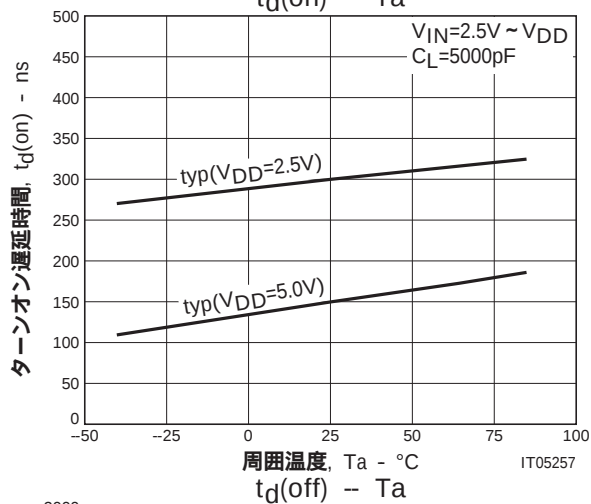
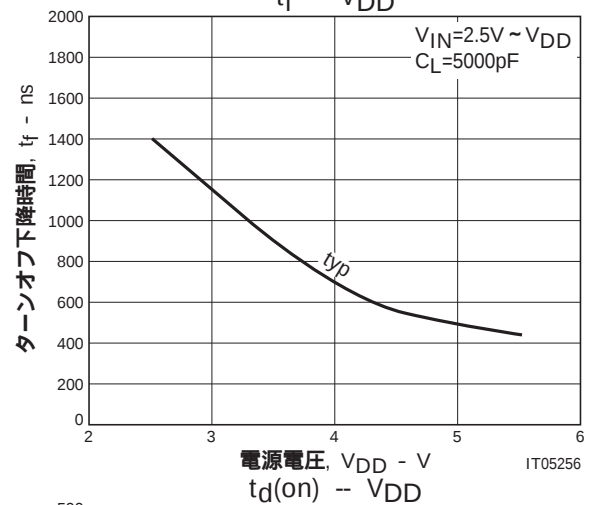
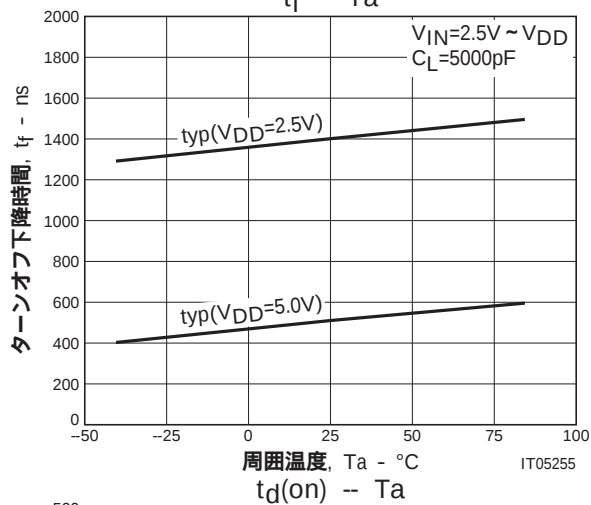
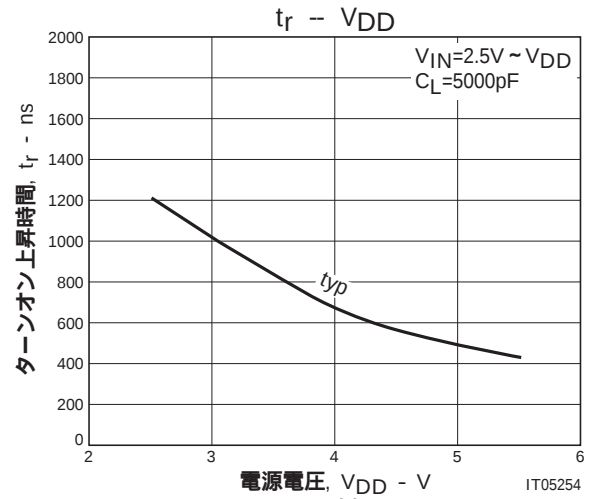
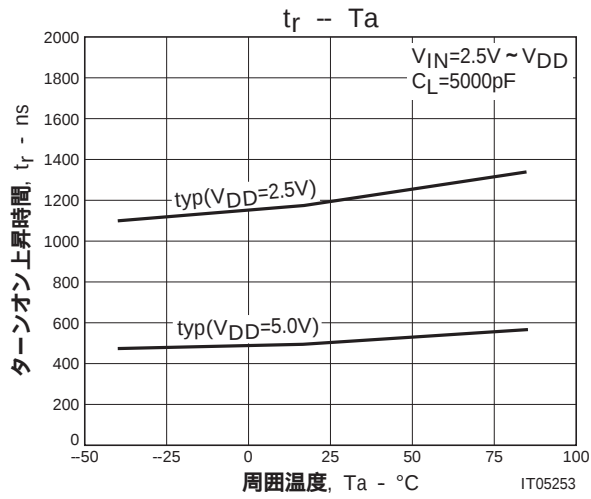
ブロックダイアグラム



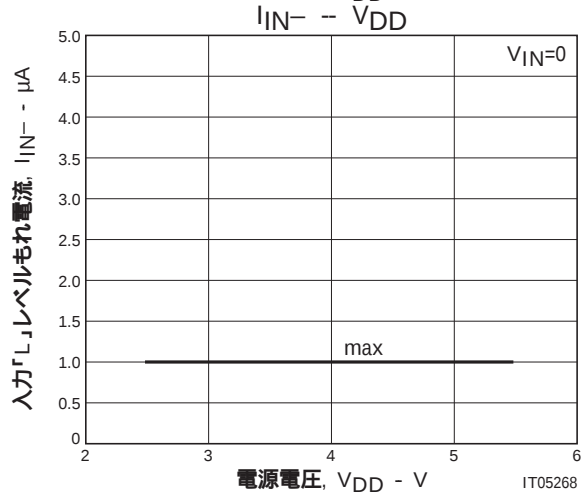
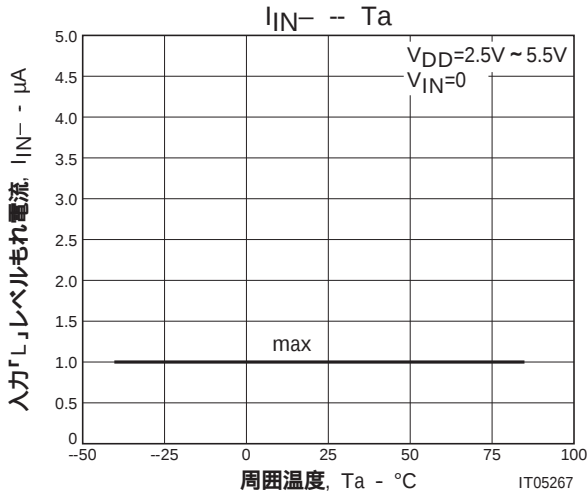
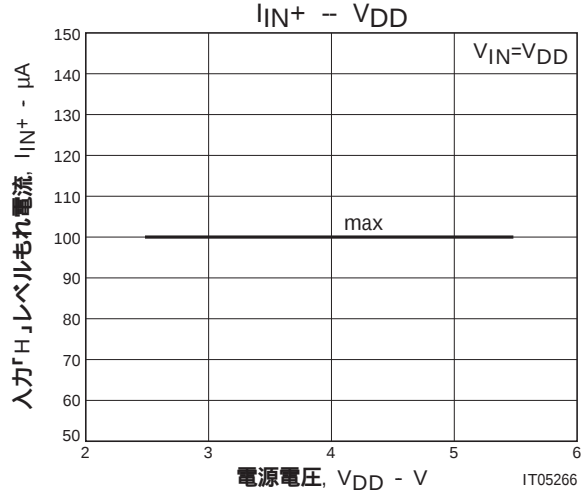
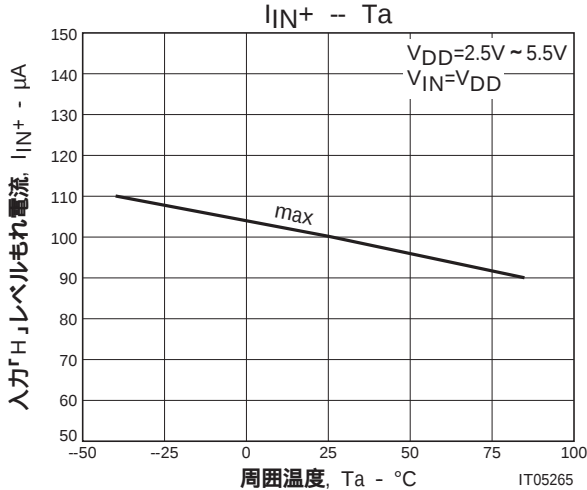
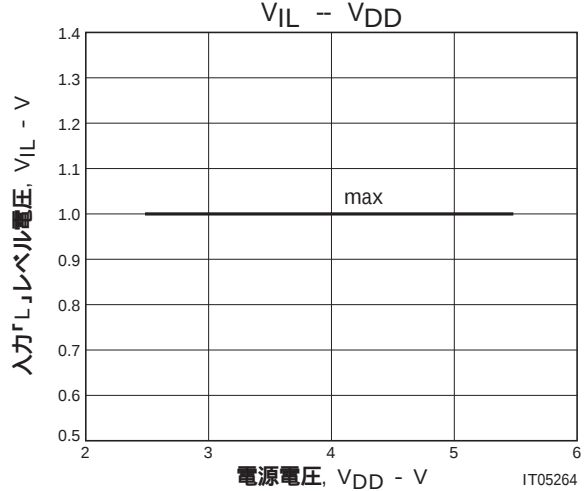
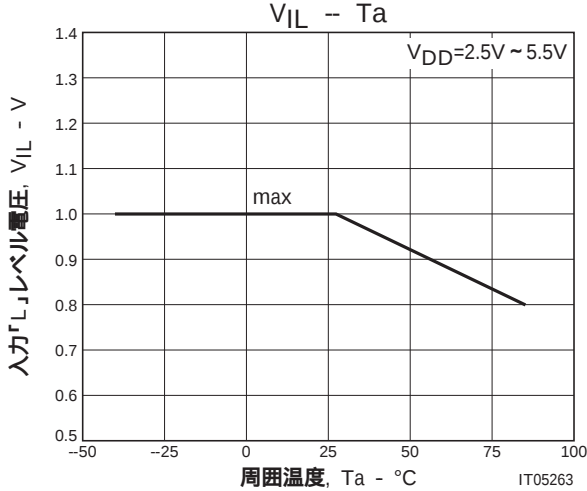
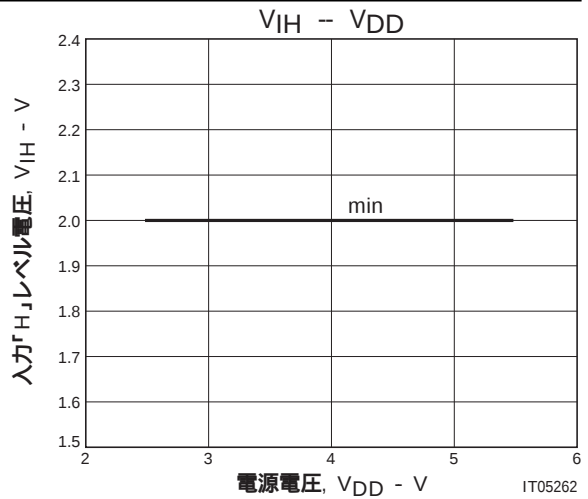
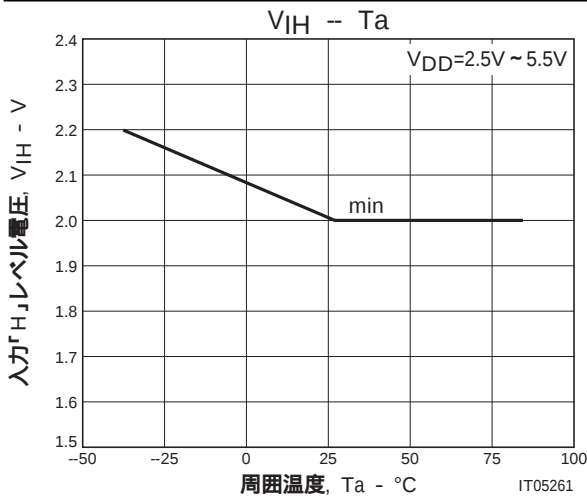
スイッチングタイム試験回路図



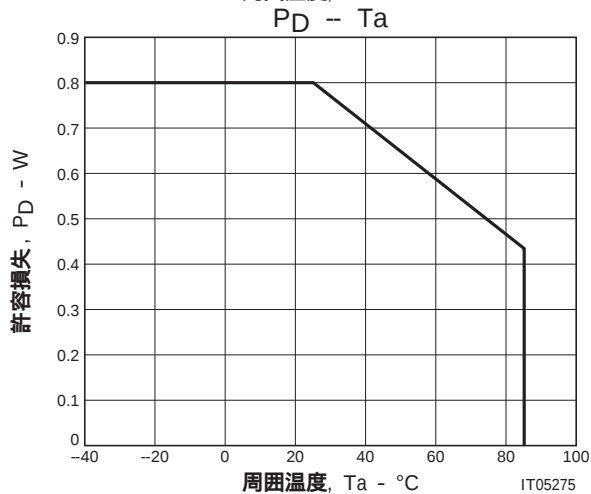
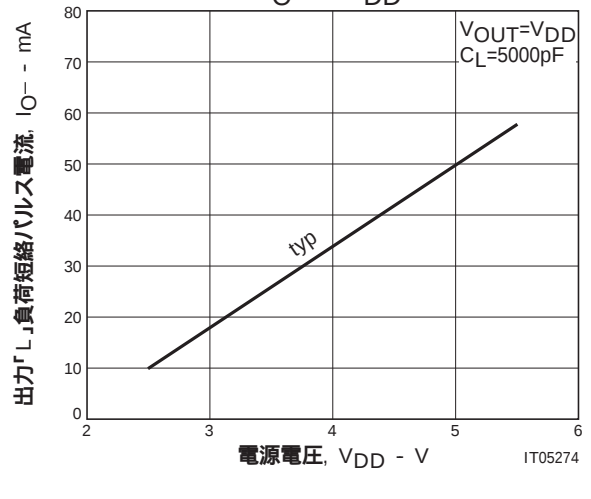
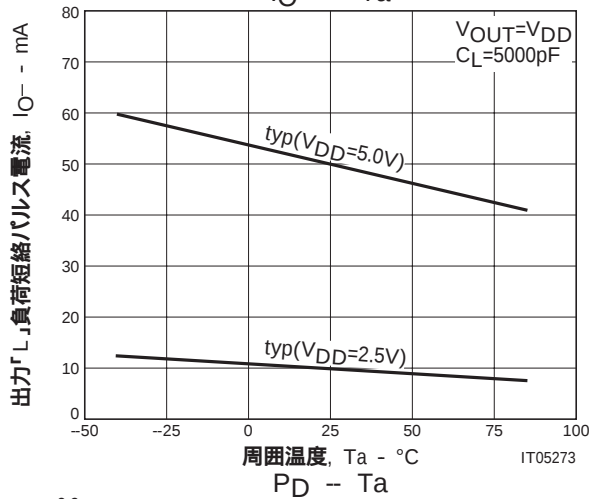
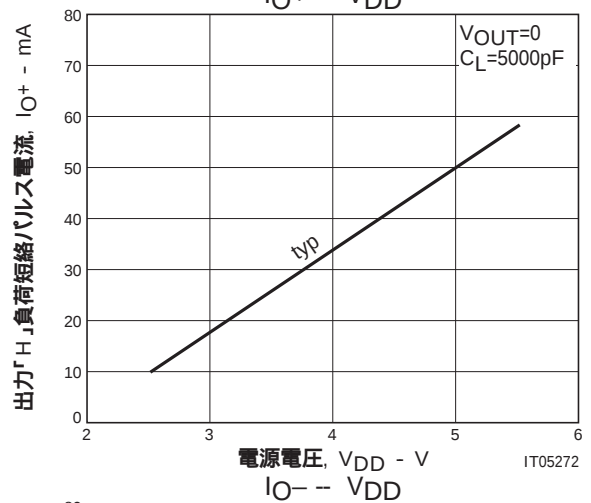
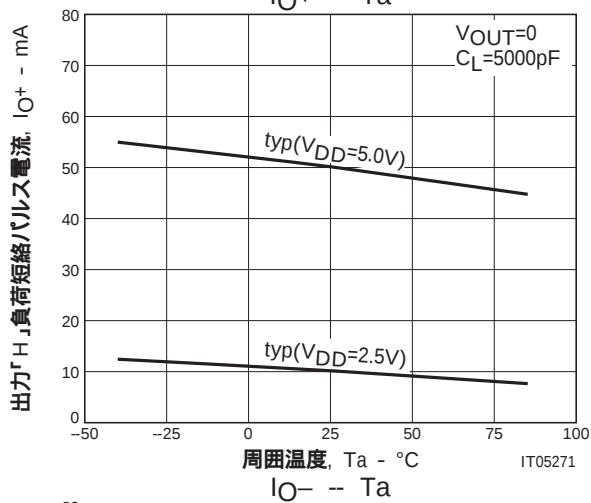
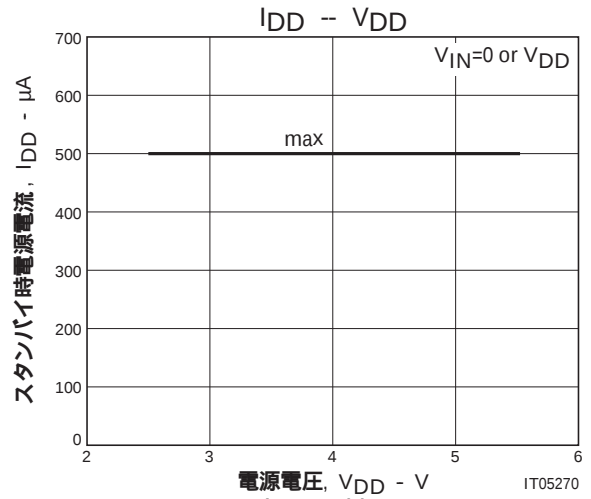
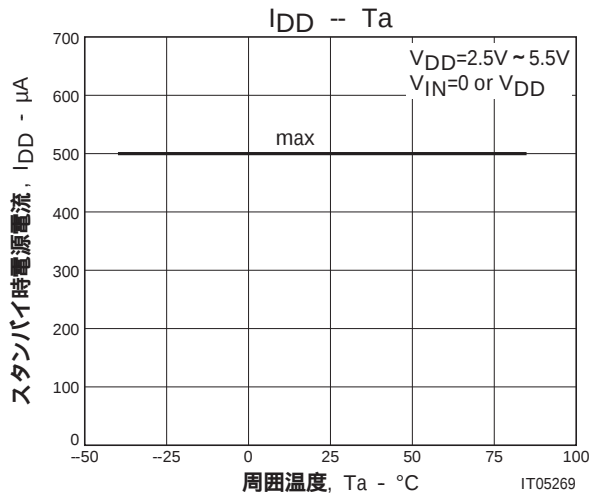
TND721MH5



TND721MH5



TND721MH5



- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。